

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日 時 平成18年10月3日（火）13:20～17:10

場 所 東北大学 電気通信研究所 ナノ・スピン実験施設 4階 カンファレンスルーム（仙台市青葉区片平2-1-1，地図：
<http://www.murota.riec.tohoku.ac.jp/lab/map.html>）

テーマ「IV族系ヘテロデバイス・システム材料技術の最新動向」

- EFM-06-15 SiGe/Si ヘテロ MOSFET におけるヘテロ界面のホットキャリア局所劣化
土屋敏章（島根大学）
櫻庭政夫，室田淳一（東北大学）1
- EFM-06-16 SiGeC HBT の真性及び外部ベースのプロセス設計
清田幸弘（ソニー）
山縣秀夫（ソニーセミコンダクタ九州）7
- EFM-06-17 スピントロニクス用強磁性シリサイド(Fe_3Si)/SiGe の低温形成
佐道泰造，上田公二，熊野 守，宮尾正信（九州大学） 11
- EFM-06-18 スパッタエピタキシー技術と量子効果デバイスへの応用
須田良幸，花房宏明，小林忠正，高橋陽一，前川裕隆（東京農工大学）15
- EFM-06-19 仮想 Ge 基板上における $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ バッファ層の歪および転位構造制御
竹内正太郎，酒井 朗，中塚 理，小川正毅，財満鎮明（名古屋大学）19
- EFM-06-20 極薄 SiGe バッファ層を用いた Si(100)基板上への Ge ヘテロエピタキシャル成長
中津留順子，伊達大樹，真白すびか，池本 学（キヤノンアネルバ）25
- EFM-06-21 Cl 系-Si 系混合ガスを用いたエピ前低温表面処理法の検討
王 杰，山本克彦，森谷 敦
橋場祥品，井ノ口泰啓，国井泰夫（日立国際電気）31

EFM-06-22	HF 酸処理 SiGe(100)表面の初期酸化過程の観察 廣瀬文彦, 永戸雅也, 木下友太 (山形大学)	35
EFM-06-23	ECR プラズマ CVD による IV 族半導体エピタキシャル成長 櫻庭政夫, 武藤大祐, 森 聖樹, 菅原勝俊, 室田淳一 (東北大学)	39
EFM-06-24	Si 基板上 SiC 極薄膜の低温形成とユビキタスデバイスへの応用 末光真希*, 今野篤史 (東北大学) 成田 克 (九州工業大学) 伊藤 隆 (東北大学) 安井寛治 (長岡技術科学大学) 中澤日出樹 (弘前大学) 遠藤哲郎 (東北大学)	45

協 賛 IV族系ヘテロ超微細デバイス材料技術調査専門委員会